

Comunicato stampa

KIOXIA inizia le spedizioni di campioni di dispositivi BiCS FLASH™ 1Tb TLC di 9a generazione

I nuovi dispositivi integrano le celle di memoria esistenti e le tecnologie CMOS avanzate per ottenere un'elevata efficienza dell'investimento

Düsseldorf, Germania, 6 agosto 2026 – [KIOXIA Europe GmbH](#), leader mondiale nelle soluzioni di memoria, ha annunciato che KIOXIA Corporation ha avviato di spedizioni dei campioni di dispositivi di memoria TLC (Triple-Level Cell) da 1Tb (terabit) che incorporano la sua tecnologia di memoria flash BiCS FLASH™ 3D di 9a generazione^[1]. I dispositivi sono progettati per supportare le applicazioni quali i PC e gli smartphone con funzionalità di IA con capacità di archiviazione di livello medio-basso che richiedono prestazioni elevate.

KIOXIA continua a perseguire una strategia a doppio asse basata sulla sua innovativa tecnologia CMOS directly Bonded to Array (CBA)^[2] e sulla tecnologia On-Pitch Select Gate Drain (OPS)^[3]. Con la sua strategia unica a doppio asse, KIOXIA sta contemporaneamente promuovendo due linee di prodotto distinte: le soluzioni di 9a generazione, che offrono alte prestazioni a costi di investimento relativamente bassi, e la tecnologia di 10a generazione, che sfrutta lo stacking avanzato degli strati per raggiungere una capacità elevata e prestazioni superiori.

I nuovi dispositivi TLC BiCS FLASH™ 1Tb di 9a generazione, sviluppati utilizzando un processo di impilamento a 230 strati basato sulla tecnologia BiCS FLASH™ di 8a generazione e sulla tecnologia CMOS avanzata, offrono una velocità di interfaccia NAND di 4,8Gb/s, un miglioramento

del 33% rispetto ai dispositivi di 8a generazione, eguagliando le prestazioni dei dispositivi di 10a generazione^[4].

Ispirata dalla propria missione di “migliorare il mondo grazie alla ‘memoria’”, KIOXIA continua a impegnarsi per promuovere l’innovazione tecnologica, rafforzare le partnership globali e fornire soluzioni di archiviazione all’avanguardia che alimentano le moderne infrastrutture di intelligenza artificiale.

#

Note:

1: questi campioni sono stati realizzati allo scopo di verificarne la funzionalità; le specifiche effettive potrebbero differire nella produzione in serie.

2: tecnologia in base alla quale ogni wafer CMOS e ogni wafer con matrice di celle vengono prodotti separatamente in condizioni ottimizzate individualmente e successivamente uniti tra loro. Questa tecnologia è stata adottata a partire dai prodotti BiCS FLASH™ di 8a generazione.

3: tecnologia che consente di accorciare la linea di bit e ridurre la capacità della linea di parola eliminando i fori di memoria inutilizzati. Questa tecnologia è stata adottata a partire dai prodotti BiCS FLASH™ di 8a generazione.

4: 1 Gb/s è calcolato come 1.000.000.000 bit al secondo. Questo valore è stato ottenuto in un ambiente di test specifico presso KIOXIA Corporation; i risultati possono variare nell'uso effettivo a seconda delle condizioni di utilizzo.

La densità del prodotto viene identificata in base alla densità del chip (o dei chip) di memoria all'interno del prodotto, e non alla capacità di memoria disponibile per l'archiviazione dei dati da parte dell'utente finale. La capacità utilizzabile dall'utente finale sarà inferiore a causa delle aree di dati in eccesso, della formattazione, dei blocchi danneggiati e di altri vincoli e può variare anche in base al dispositivo host e all'applicazione. Per maggiori dettagli, consultare le specifiche del prodotto. 1Gb = 2^{30} bit = 1.073.741.824 bit.

Le velocità di lettura e scrittura sono le migliori ottenute in un ambiente di test specifico presso KIOXIA Corporation e l'azienda non garantisce né la velocità di lettura né quella di scrittura nei singoli dispositivi. Le velocità di lettura e scrittura dipendono dal dispositivo utilizzato.

I nomi di aziende, prodotti e servizi possono essere marchi di proprietà di terze parti.

**Informazioni su KIOXIA Europe GmbH**

KIOXIA Europe GmbH è la filiale europea di KIOXIA Corporation, leader mondiale nella fornitura di memorie flash e unità a stato solido (SSD). Dall'invenzione della memoria flash NAND all'attuale rinomata memoria flash 3D BiCS FLASH™, KIOXIA continua a essere pioniera di soluzioni e servizi di memoria innovativi che arricchiscono la vita delle persone e ampliano gli orizzonti della società. L'innovativa tecnologia di memoria flash 3D BiCS FLASH™ della società sta plasmando il futuro dell'archiviazione nelle applicazioni ad alta densità, tra cui smartphone avanzati, PC, sistemi automobilistici, data center e sistemi di IA generativa.

Visita il nostro [sito web di KIOXIA](#)

Contatti per la pubblicazione:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 183, 40549 Düsseldorf, Germania

Tel: +49 (0)211 368 77-0

E-mail: KIE-support@eu.kioxia.com

Dati di contatto per richieste redazionali:

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 382

E-mail: lena.hoffmann@eu.kioxia.com

Pubblicato da:

Birgit Schöniger, Pretzl GmbH

Tel: +49 (0)172 617 8431

E-mail: birgit.schoeniger@pretzl.com

Web: www.pretzl.com